

深圳市晶泰源电子有限公司

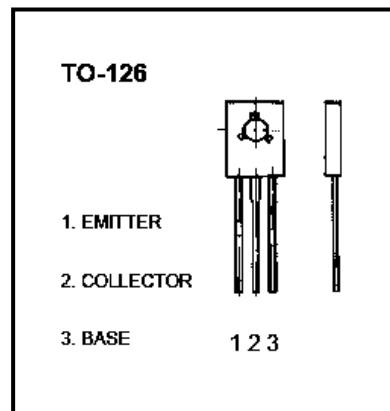
2SB772 PNP 晶体管

1、封装形式：TO-126

2、互补型号：2SD882

3、极限参数(绝对最大额定值 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数值	单位
集电极-基极电压	BV_{CBO}	-40	V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	-25	V
集电极最大电流	I_{CM}	-3	A
耗散功率	P_{D}	2	W
贮存结温	$T_{\text{j}}, T_{\text{stg}}$	-55~+150	°C



4、电参数特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极电压	BV_{CBO}	$I_{\text{C}}=-100 \mu \text{A}, I_{\text{E}}=0$	-40			V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	$I_{\text{C}}=-10 \text{mA}, I_{\text{B}}=0$	-25			V
发射极-基极电压	BV_{EBO}	$I_{\text{E}}=-100 \mu \text{A}, I_{\text{C}}=0$	-6			V
集电极-基极漏电流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-40 \text{V}, I_{\text{E}}=0$			-1	μA
集电极-发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{\text{CE}}=-25 \text{V}, I_{\text{B}}=0$			-10	μA
发射极-基极漏电流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-6 \text{V}, I_{\text{C}}=0$			-1	μA
直流放大倍数	$H_{\text{FE}}(1)$	$V_{\text{CE}}=-2 \text{V}, I_{\text{C}}=-1 \text{A}$	-60		-400	
	$H_{\text{FE}}(2)$	$V_{\text{CE}}=-2 \text{V}, I_{\text{C}}=-100 \text{mA}$	-32			
饱和压降	V_{CESAT}	$I_{\text{C}}=-2 \text{A}, I_{\text{B}}=-0.2 \text{A}$			-0.5	V
正向压降	V_{BESAT}	$I_{\text{C}}=-2 \text{A}, I_{\text{B}}=-0.2 \text{A}$			-2	V
特征频率	f_{T}	$V_{\text{CE}}=-5 \text{V}, I_{\text{B}}=-100 \text{mA}$	50			MHz